



No.964

2222

STK8280

厚膜混成集積回路
80W min AF パワーアンプ出力段 (2 電源)
疑似 A 偏置回路内蔵



- 特長
- ・B クラスアンプ不可避のスイッチングひずみをゼロとしている。
 - ・パワー段とバイアスコントロール回路 および 温度補償回路は熱結合の良いように組み込まれているため サーミスタ等の複雑な温度補正は必要なく 熱的に安定。
 - ・バイアス電流の設定を外部的に行なうことにより 最適な条件設定ができる。

最大定格 / $T_a = 25^\circ\text{C}$

項目	記号	条件	値	単位
最大電源電圧	$V_{CC \text{ max}}$		± 65	V
熱抵抗	θ_{j-c}	理想放熱状態	1.4	$^\circ\text{C}/\text{W}$
コレクタ電流	I_C		2	A
接合部温度	T_j		150	$^\circ\text{C}$
保存周囲温度	T_{stg}		$-30 \sim +105$	$^\circ\text{C}$
負荷短絡許容時間	t_b	$V_{CC} = \pm 47\text{V}^*$, $f = 50\text{Hz}$, $P_o = 80\text{W}$, $R_L = 8\Omega$	2	sec

推奨動作条件 / $T_a = 25^\circ\text{C}$

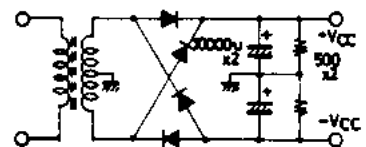
項目	記号	値	単位
推奨電源電圧	V_{CC}	± 47	V
負荷抵抗	R_L	8	Ω

動作特性 / $T_a = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = \pm 47\text{V}$, $R_L = 8\Omega$, $R_g = 600\Omega$, $V_G = 26$, 5dB, 指定測定回路 (応用回路例に準ずる) において。

項目	記号	条件	min	typ	max	単位
無信号電流	I_{CCO}	$V_{CC} = \pm 55\text{V}^{**}$			80	mA
出力電力	P_o	THD = 0.01%, $f = 20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$	80			W
全高調波ひずみ率	THD	$P_o = 1.0 \sim 80\text{W}$, $f = 20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$			0.01	%

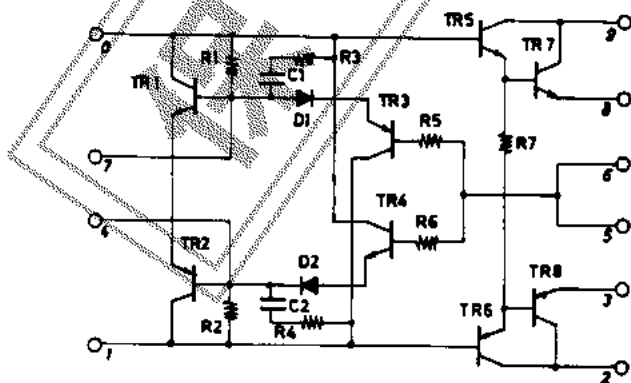
*: 負荷短絡許容時間は右図の指定トランス電源を使用する。

** : 指定回路 VR1 (30k Ω) 抵抗値最大とする。

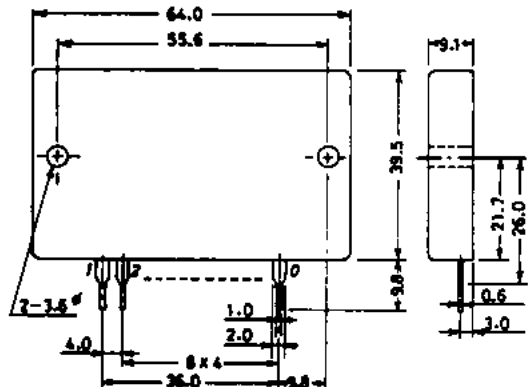


指定トランス電源
(タンゴ MG-200#相当)

等価回路



外形図 4006
(unit: mm)



* これらの仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。

